

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 59-143324
(43)Date of publication of application : 16.08.1984

(51)Int.CI. H01L 21/30
G03F 7/20

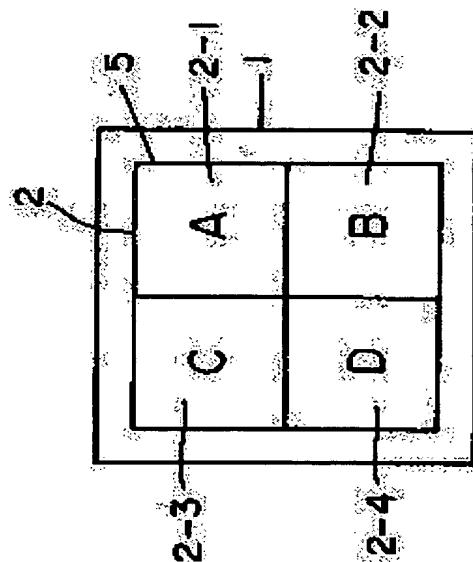
(21)Application number : 58-015501 (71)Applicant : OKI ELECTRIC IND CO LTD
(22)Date of filing : 03.02.1983 (72)Inventor : ASHIDA ITSUJI

(54) FORMATION OF PATTERN

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the efficiency of pattern formation by the method wherein after the compound pattern, which is compounded by repeating one pattern (n) times, is exposed collectively at once, this collective exposure is repeated to expose the same pattern by the same position from once to (n) times at most.

CONSTITUTION: A reticule pattern 2 is compounded by repeating the same device patterns 2-1W2-4 n (4) times and a reticule 1 is used for pattern formation. After this compound pattern 2 is exposed collectively, it is repeated to expose the pattern or patterns collectively with displacing them and using a blank mask. By repeat exposure, one pattern is exposed once or n (4) times at most by the same position. In addition, each exposure is performed with light volume of $1/n$ of the maximum light volume, thereby improving the efficiency of pattern formation.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑨ 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭59—143324

⑤ Int. Cl.^a
H 01 L 21/30
G 03 F 7/20

識別記号

序内整理番号
Z 6603—5F
7124—2H

⑥ 公開 昭和59年(1984)8月16日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 5 頁)

④ パターンの形成方法

⑦ 特 願 昭58—15501
⑧ 出 願 昭58(1983)2月3日
⑨ 発明者 芦田逸治
東京都港区虎ノ門1丁目7番12

号冲電気工業株式会社内
⑩ 出願人 沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門1丁目7番12
号
⑪ 代理人 弁理士 菊池弘

明細書

1. 発明の名称

パターンの形成方法

2. 特許請求の範囲

同一パターンをn個リピート合成した合成パターンのレチクルを用い、合成パターンを一括露光し、以後、一パターンまたは複数個のパターンずらして合成パターンを一括露光することをくり返すことにより、一パターンを少なくとも1回、最高n回同一箇所に露光するようにし、かつ各回の露光は最適露光量の $1/n$ の露光量で露光を行うことを特徴とするパターンの形成方法。

3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

この発明は、LSI製造用ウエーハステップバーまたはフォトマスク製造用フォトリビータを用いてウエーハまたはフォトマスク上に所定のパターンを形成する方法に関するものである。

(従来技術)

従来、LSI製造用ウエーハステップバーまたは

フォトマスク製造用フォトリビータを用いて所定のパターンングを行う場合、その前に充分レチクルを検査しても、その検査後、レチクル上のパターンの透明部分に異物が付着すると、形成されるウエーハまたはフォトマスク上のパターンはそれぞれ共通の欠陥(繰り返し欠陥)が発生してしまい良品チップが皆無になつてしまつという欠点があつた。

フォトマスクの場合共通欠陥が1ヶ位であれば、レーザトリマなどの欠陥修正機で修正することが可能である(ただし、ハードマスクのアイランド状の黒ピンに限る)が、共通欠陥数が2ヶ以上になると、修正工数が増えて工数損失が大となるため再露光しなければならない。また、1ヶであつても欠陥がパターン部(图形)に接触している場合は、修正後のパターンエッジ形状が直線でなければならないため、精度的あるいは工数的に不可避である。

一方、ウエーハの場合、フォトマスクよりも更に条件が厳しく、現在のところ共通欠陥が発生し

大場合の修正方法がない。また、今後できたとしても、ウエーハ毎(全チップにわたつて)に修正するのは著しい工数増加を強いられ、事实上不可能といつても過言ではない。

(発明の目的)

この発明は上記の点に鑑みなされたもので、その目的は、ウエーハまたはフォトマスクのパテニアリングにおいて共通欠陥が発生した場合は上記のように修正が不可能なことから、共通欠陥を発生させないパターンの形成方法(露光方法)を提供することにある。すなわち、レチクル欠陥(黒ピン、白ピン、パターンくずれなど)およびレチクルへの異物の付着がレチクル上に存在しても、同一場所に同一欠陥が発生する確率は皆無に等しい製造方法を得ることにある。

(実施例)

以下この発明の一実施例を図面を参照して説明する。

第1図はこの発明の一実施例に使用するレチクルで、同一パターンをリピート合成(多面パターン)

3

クロム膜またはエマルジョン膜で形成された欠陥か、またはレチクル上に付着した異物である。また、白ピン4-2とパターンくずれ凹4-3は、レチクル作製時に発生するクロム膜またはエマルジョン膜の欠け(透明部)である。

この発明の一実施例では、同一パターンを複数個有する(合成チップを有する)第1図のレチクルを用いてウエーハまたはフォトマスクのパテニアリングを行なうべく露光を行う。第2図はその露光の方法を説明するために、第1図のレチクルを簡略化して示す図である。この図において、1は同一パターン(チップ)を複数個(この一実施例では4個)有するレチクル、2はレチクルパターン(4チップ)、2-1, 2-2, 2-3, 2-4はそれぞれ同一のアバイスパターンで、説明の便宜上、アバイスパターン2-1をA, アバイスパターン2-2をB, アバイスパターン2-3をC, アバイスパターン2-4をDと記号に置き換える。5はクリンドラインである。

この発明の一実施例では、レジストコーティン

ンで通常4チップ合成が望ましい)したパターンを有する。

このレチクルについて第1図により更に詳述すると、1はそのレチクル(ハードレチクルまたはエマルジョンレチクル)、2はパターンセネレータまたは電子ビーム露光装置により同一パターン(1チップ)を複数個(2個以上)繰り返し露光(リピート露光)することにより作製したレチクルパターンで、2-1, 2-2, 2-3, 2-4がそれぞれ同一のアバイスパターン(1チップ)である。この4つのアバイスパターン2-1~2-4から明らかかのように、第1図は4個チップ合成した例である。3はI/C(アバイス)の内部パターン、4はレチクル欠陥で、その種類としては符号4-1で示す黒ピン、符号4-2で示す白ピン、符号4-3で示すパターンくずれ凹、符号4-4で示すパターンくずれ凸がある。5はクリンドラインである。さらに、前記レチクル欠陥4について詳細に説明を加えると、黒ピン4-1とパターンくずれ凸4-4は、レチクル作製時に発生する

4

グを行いブリペーク(ソフトペーク)が施されたマスク用プランクまたはウエーハに対して、パテニアリングを行うために、第2図のレチクルのA, B, C, Dの同一パターンを一括露光する。さらに、レチクルを1チップのピッチサイズでらずしながらリピート露光する。

第3図は、符号9で示す露光機の走査軌跡のようにレチクルを1チップのピッチサイズでらずながら、マスク用プランクまたはウエーハ(ウエーハへの場合は勿論形状は円形が一般的である)7に対してもリピート露光を行つた様子を示す図である。この図において、8-1, 8-2, 8-3…, 8-nは各アバイスチップのパターン(露光のみ完了していて現像は未だ施されていない状態)、8はこれらパターン8-1~8-nの全体を表わすパターン群である。

このパターン群8の中でA₁, B₁, C₁, D₁はマスク用プランクまたはウエーハ7上にレチクルの合成パターンA, B, C, Dがフォトリビータまたはステッパーの露光機で第1回目の露光により一

5

-112-

6

括弧光されたことを示す。また、 A_2 、 B_2 、 C_2 、 D_2 は第2回目の一括露光を示し、以下同様にして A_n 、 B_n 、 C_n 、 D_n は n 回目に一括露光が行われたことを示す。したがつて、図から判断されるように、1チップの中に記号が1ヶのものは1回のみ露光されたことを示し、2ヶのものは2回(二重露光)、4ヶのものは同一パターンが4回(四重露光)露光が行われたことを示す。

第3図の例のごとくアバイスチップが矩形配列されている場合は、四隅の4チップが1回露光、その4チップを除いた最も外周列の残りのチップが2回露光(二重露光)され、その他の残りのチップはすべて4回露光(四重露光)される。この場合、露光エネルギ量は、通常1チップ露光の適正エネルギ量の $1/n$ にするのが望ましい。この場合の n は第2回のレチクル上におけるチップ合成数を意味し、前記マスク用プランクまたはウエーハ上における最大多重露光回数とも等しい。この $1/n$ の露光エネルギ量で露光すれば、第3図の上下・左右の各最外列以外のパターンは最適露光量(

いてウエーハステッパーまたはフォトリビータなどでウエーハまたはマスク用プランクを露光する際にレチクルに付着する異物によるレチクル欠陥の発生を解決できる。したがつて、最近使用され始めたレチクル欠陥防止用保護膜を使用する必要がなくなる。

また、この一実施例では、前述のように、各回の露光において最適露光量の $1/n$ しか露光していないので、チップ毎に $1/n$ 露光する方法に比較して露光時間を短縮することもできる。

なお、第3図において、上下・左右のチップ最外列はチップの露光エネルギ量が正常なパターンを行なうのに不足するため良品のチップが得られないが、通常ウエーハでこの部分のチップは良品の探れない箇所であるから問題はない。この部分も良品としたい場合は、もう一列ないし2列、X方向およびY方向に配列数を増加すればよく全く問題がない。

また、露光配列方法は矩形でも円形でもいずれの場合にも適用できることとはいうまでもない。

n/n = 通常露光エネルギー)となる。

このように一実施例では、上下・左右の最外列以外のパターンは最適露光量 n/n となるが、次に、それらのパターンにおいて、レチクル欠陥の部分がどのように露光され如何なる状態になるか考えてみる。いま、マスク用プランクまたはウエーハにポジレジストをコーティングしてパターンニングを行う場合を例にとると、黒ピンとパターンくずれ凸は $1/n$ 露光され、現像後除去される。一方、白ピンとパターンくずれ凹は $1/n$ しか露光されないため、現像してもパターンニングされず、欠陥として現われない。このように一実施例では、レチクル(エマルジョンまたはハードの)上の分割された各チップに同一箇所に同一形状の欠陥(共通欠陥)がない限り(あつたとしても同一箇所でなければ可)、すべてのレチクル作製露光機(パターンセネレータまたは電子ビーム露光装置、X線露光装置など)により露光される露光以降のプロセスが原因で発生するレチクル欠陥の発生および、正常なレチクルを作製し、このレチクルを用

さらに、上記一実施例では、レチクルを1チップのピッチサイズでずらしながらリピート露光する場合について説明したが、レチクル上のチップ合成数によつては2チップ以上のピッチサイズでずらすこととも考えられる。

(発明の効果)

以上詳述したようにこの発明のパターンの形成方法は、同一パターンを n 個リピート合成した合成パターンのレクチャルを用い、合成パターンを一括露光し、以後一パターンまたは複数個のパターンずらして合成パターンを一括露光することをくり返すことにより、一パターンを少なくとも1回、最高 n 回同一箇所に露光するようにして、かつ各回の露光は最適露光量の $1/n$ の露光量で露光を行うことを特徴とする。したがつて、この発明の方法によれば、アバイス製造におけるステッパー(ウエーハ露光)およびフォトマスク製造におけるフォトリビータ(マスクプランク露光)のそれぞれの露光作業において共通欠陥のないパターンングが可能になることは勿論、レチクル上の黒ピン、白ピン、

パターンくずれ(凹および凸)などのいわゆるレチクル欠陥があつても、また正常なレチクルに露光作業中異物が付着しても除去しないで露光するとこれが可能となり、著しい能率の向上を期待できる。概論すれば、ウエーハおよびマスクプランクの露光作業での検査工程は全く不要となり、レチクル製作工程においても露光以後のプロセスに起因する欠陥は検査を大幅に省略できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図ないし第3図はこの発明のパターンの形成方法の一実施例を説明するための図で、第1図はレチクルを示す平面図、第2図はそのレチクルを簡易化して示す平面図、第3図は第1図および第2図のレチクルを用いてマスク用プランクまたはウエーハに対してリピート露光を行つた状態を示す平面図である。

1…レチクル、2…レチクルパターン、2-1～2-4…ナバイスピターン、3…L/C (ナバイスピの内部パターン)、7…マスク用プランクまたはウエーハ、8…パターン群、8-1～8-n…

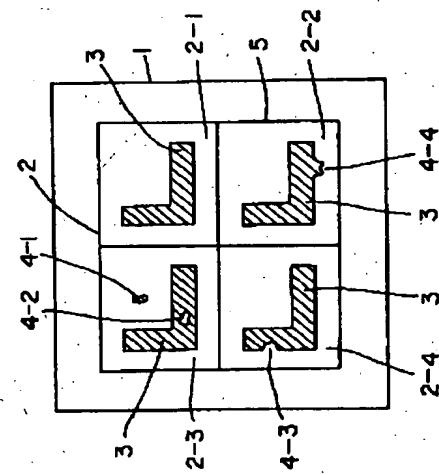
各アバイスピターンのパターン。

特許出願人 神電気工業株式会社

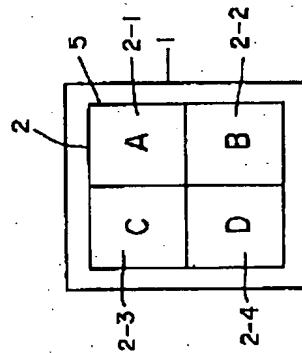
代理人弁理士 東 勝



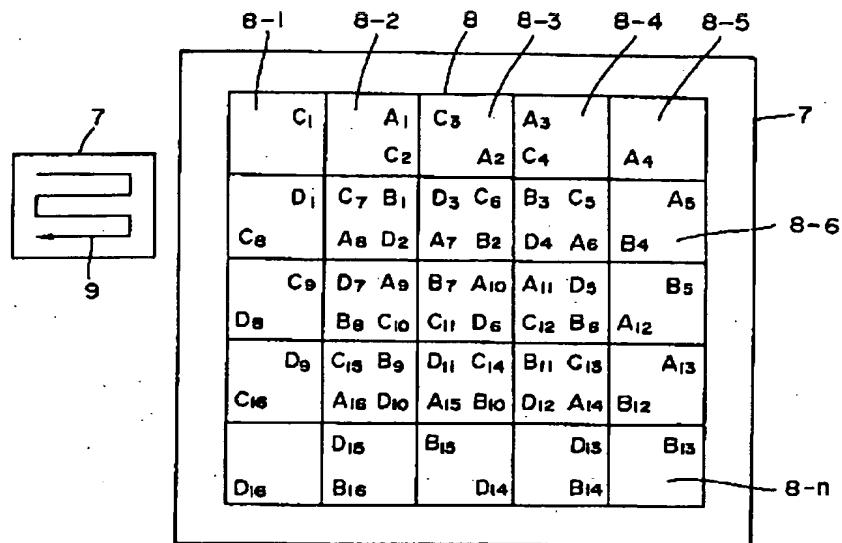
第1図



第2図



第3図



手続補正書

昭和58年10月19日

特許庁長官若杉和夫殿

1. 事件の表示

昭和58年 特許願第15501号

2. 発明の名称

マターンの形成方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

(029) 沖電気工業株式会社

4. 代理人

〒106 東京都港区虎ノ門一丁目2番20号 第18号
弁理士 菊池 弘
コード第6568号 電話 501-2453(代表)

5. 補正命令の日付 昭和 年 月 日 (自発)

6. 補正の対象

明細書の発明の詳細を説明の欄

7. 補正の内容

別紙の通り

7. 補正の内容

- 1) 明細書1頁17行「フォトマスク上に」を「フォトマスク用ブランク上に」と訂正する。
- 2) 同4頁6行「露光装置により」を「露光装置などにより」と訂正する。
- 3) 同5頁8行「フォトマスクの」を「フォトマスク用ブランクに」と訂正する。